X線回折顕微法の原理

西野吉則 理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センター

〒678-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1

石川哲也 理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センター

〒678-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1

要 旨 X線回折顕微法は,試料の結晶化を要さず,X線回折強度データから電子密度分布を再生する斬新な手法である。実験では,微小試料全体がコヒーレント X線によって照射されることが不可欠である。これにより回折強度パターンは,X線の波長程度の空間分解能での試料構造敏感性を持つ。本手法では位相問題への解として,X線回折強度パターンをオーバーサンプリング条件を満たすように細かくサンプリングする。回折強度からの試料構造の再生には反復法が用いられる。将来の SASE FEL 光源を用いた野心的な計画として,試料構造のスナップショットをフェムト秒の時間分解能で測定することが議論されている。

1. はじめに

X線結晶構造解析法を空間的周期構造を持たない一般の試料に拡張した新たらしい顕微法が、本稿で紹介する X線回折顕微法である。この手法では試料の結晶性を仮定しないため、これまで X線結晶構造解析法で扱うことが困難または不可能であった試料に対しても、 X線回折に基づく構造解析の適用の場が広がる。 X線の波長程度の高空間分解能と、 X線の高い透過性による長いプローブ深さを併せ持つ、比類のない高空間分解能三次元構造解析を可能にする顕微法として注目を集めている。

X線回折顕微法は、X線結晶構造解析法と同様に、試料の回折強度データから試料構造を再生する。試料から十分遠方でのX線回折波の複素振幅は、試料の電子密度分布のFourier変換で与えられるが、観測可能な物理量は強度のみで、位相は直接測定できない。このため、逆Fourier変換(Fourier合成)により電子密度を再生するためには、位相の回復が必要である。このよく知られたX線回折における位相問題は、X線結晶構造解析法とX線回折顕微法に共通に存在する。

X線回折顕微法における位相回復は、回折強度パターンを逆空間で十分細かく測定することにより実現する。ちなみに、X線回折顕微法で扱う微小試料による回折強度は連続的に分布するため、細かいサンプリングが可能となる。X線回折強度データからの位相回復には、計算機上での反復法が用いられる。レンズによる結像を用いた一般的な顕微鏡では、レンズにより逆 Fourier 変換が実効的に行われるが 11 , X線回折顕微法ではこのレンズの役割を計算機が果たしていると言える。

X線回折顕微法では、観察したい試料領域全体がコヒーレント X線で照射されていることが必須である。このため実験では、高コヒーレントフラックス X線源が求められる。現状では、SPring-8 のような低エミッタンス電子ビーム蓄積リングのアンジュレータ放射光が測定に用いられている。

さらに卓越したコヒーレンス性能を持つ次世代オングストローム波長 X 線光源,SASE(Self-Amplified Spontaneous Emission:自己増幅自然放出)FEL(Free Electron Laser:自由電子レーザー)の計画が現在,日本(SCSS),欧州(XFEL),米国(LCLS)で検討されている。日本では,理化学研究所が SPring-8 サイトで SCSS(SPring-8 Compact SASE Source)プロジェクト^{2,3)}を計画している。SASE FEL の短パルス,高ピーク輝度という優れた特性を利用することにより,X 線回折顕微法をさらに時間軸方向に発展させた,超高精度四次元構造解析が可能になると期待されている。

ここで、X線回折顕微法の開発の歴史を振り返る。X線回折顕微法は、X線結晶構造解析における直接法の先駆者である David Sayre が、1952年に回折強度をオーバーサンプリングすることによる位相回復の可能性を説き 4)、その後この原理に基づく顕微法を着想したことに始まる 5)。Fourier 強度からの反復的位相回復法に関しては、1970年代から電子顕微鏡や天文学等におけるデジタル画像解析の分野で研究が進められた 6 、Sayre は、遅くとも1990年代初頭にこの位相回復法の存在を知り、現在行われている X線回折顕微法の処方を描いた 8 。それ以前の1980年代から、Sayre は New York 市立大学 Storny Brook 校の Janos Kirz を中心とする X 線光学・顕微法グ

ループと共同で、NSLSのビームライン U15や X1A において、結晶性を持たない微小試料の軟 X 線による回折実験を行ってきた 9^{-11} 。そして、X 線回折顕微法の最初の実験的成功が、Kirz グループで Sayre の指導を受けた当時の大学院生 Jianwei Miao らにより1999年に Nature 誌に発表され多くの関心を集めた 12^{-1} 。この論文では、金で作られた文字パターンの波長 $1.7\,\mathrm{nm}$ の軟 X 線による回折強度データから、試料像再生を行った結果が報告された。この成功を受け、X 線回折顕微法の研究はその後世界的な広がりを見せている。現在、この手法をメインテーマの一つとする国際ワークショップ(X 線コヒーレンス国際ワークショップ)が隔年で開かれるようになり、将来的なSASE FEL の利用も視野に入れた活発な議論がされている。

X線回折顕微法の名称に関しては、この分野のコミュニティーでも統一が取れていないのが現状である。2005年に開かれた X 線コヒーレンス国際ワークショップにおいても、本手法の名称に関する議論が行われた。Kirz はこの手法を (x-ray) diffraction microscopy と呼ぶことを推奨し、coherent (x-ray) diffraction imaging 等の他の名称は相応しくないと述べた。本稿では x-ray diffraction microscopy の日本語直訳として、X 線回折顕微鏡法と呼ぶことにする 13 。

本稿は以下のように構成される。まず2節では,X線回折とスペックルについて,X線回折顕微法に即した形で論じる。引き続き,3節では位相回復の必要条件であるオーバーサンプリング条件について,そして4節では位相回復の具体的な手法である反復法について解説する。5節では,X線回折顕微法実験で要求されるX線のコヒーレンスに関する条件を示す。6節では,世界各地の放射光施設で進められているX線回折顕微法実験の状況について概説する。最終のY節では,本稿のまとめと,X線回折顕微法の展望について記す。

なお、本稿では主に X 線回折顕微法の原理について論じ、実験や応用に関する詳細は割愛する。我々が SPring-8 理研物理科学ビームライン BL29XUL でこれまで行ってきた X 線回折顕微法実験については、本稿とほぼ同時に準備を進めている日本語解説記事、参考文献14)を参考にして頂けると幸いである。

2. X 線回折とスペックル

2.1 スペックル

X線は波としての性質を有し、波長程度のサイズの構造体による散乱で回折を起こす。結晶はX線の波長程度の周期での周期構造を持つため、結晶構造を反映した顕著なX線回折が起こる。この性質を利用した結晶構造解析が広く行われているのは周知の通りである。結晶によるX線回折では、離散的な逆格子点近傍で、各単位胞から

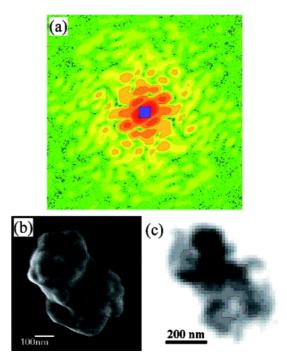


Fig. 1 (a) Diffraction intensity pattern of a single GaN particle (about 700 nm in size) measured using coherent x-rays with a wavelength of 2.48 Å at BL29XUL in SPring-8²⁶). (b) Surface morphology of the sample measured by scanning electron microscope. (c) Two dimensional projection image of the sample reconstructed directly from the diffraction data of (a)²⁶).

の散乱がコヒーレントに重なり合い,強い回折強度を与える。これに対し, X線回折顕微法で扱う結晶性を仮定しない微小試料では,回折強度は一般に連続的に分布し,かつ結晶試料に比べ極めて微弱である。

入射 X線のコヒーレンスが良い場合,無秩序な構造を持つ微小試料による回折強度パターンには,スペックルと呼ばれる斑点模様が観測される。例として,Fig. 1(a)に SPring-8 BL29XUL で測定された,サイズおよそ700 nm の窒化ガリウム単一粒子からの,波長2.48 Å の硬 X 線による回折強度パターンを示す。スペックルのコントラストの良さは,実験に用いた X 線のコヒーレンスの良さの指標となる。参考のため,Fig. 1(b)に試料の走査電子顕微鏡像(表面形状)を,Fig. 1(c)に X 線回折顕微法により Fig. 1(a)の回折強度データのみから再生された試料の二次元投影像を示す。また,Fig. 2には X 線回折顕微法実験の概略図を示す。

スペックルは試料中の各構造体からの散乱 X 線の干渉によって起こるため、X 線の波長程度の僅かな構造の違いに対しても、異なったパターンを示す。 X 線回折顕微法において、回折強度データから試料構造が決定できる根源的な理由は、スペックルパターンの試料構造に対するこの敏感性によるものである。 X 線光子相関法(X-ray Photon Correlation Spectroscopy: XPCS)においても、スペ

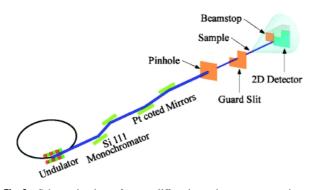


Fig. 2 Schematic view of x-ray diffraction microscopy experiment at BL29XUL in SPring-8. X-rays from the undulator source are monochromatized with a Si 111 double crystal monochromator, and higher harmonics are removed using total reflection mirrors. A pinhole and guard slits are used for precise measurement of weak diffraction intensities from the sample. Small-angle x-ray diffraction intensities are measured with a two-dimensional x-ray detector, such as an x-ray CCD detector.

ックルを用いた試料の静的構造やダイナミクスに関する研究が行われている。 X 線回折顕微法と X 線光子相関法は相補的な実験手法として現在捕らえられているが、計画が進められている SASE FEL の出現の後には、これら二つの手法が統一され、試料構造のダイナミックな変化が測定可能になると期待されている。

スペックルのサイズは試料サイズに逆比例する。これは 試料中の最も離れた構造体からの散乱 X線同士の干渉が,回折強度パターン中の最も短い周期の強度変動を生じ,試料が大きくなるなるほどその周期が短くなるためである。具体的にスペックルのサイズは,試料サイズをaとすると,逆空間で $2\pi/a$ である。前方散乱方向では,全ての散乱 X線の位相はほぼ揃うため,前方の一つのスペックル (中心スペックル) は他の二倍のサイズ $4\pi/a$ を持つ。

入射 X線のコヒーレンスが良くない場合には、スペックルパターンは波面の異なる様々な X線波の寄与で平均化され観測されない。このため、入射 X線のコヒーレンスの良さを仮定しない従来型の X線小角散乱法においては、散乱強度パターンは試料構造に関する一定の情報を与えるものの、そこから直接的に試料構造を再生することはできない。

2.2 様々な場合の X 線回折

X線回折顕微法に関わるいくつかのケースでの,X線回折について考察する。以下この節では,表式を簡単化するため,入射 X線は完全にコヒーレントな単色平面波とし,入射 X線の方向をz 軸に取る。また,回折強度はFraunhofer 近似が成り立つ十分遠方で観測するものとする。

2.2.1 微小試料による回折

微小試料による散乱では、試料物体中での X 線の多重 散乱は無視でき、運動学的回折理論が適用できる。このと き、X 線回折波の複素振幅は構造因子 F(K) (電子密度分 布 $\rho(r)$ の Fourier 変換),

$$F(\mathbf{K}) = \int d\mathbf{r} \, \rho(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} = \sum_{i} f(\mathbf{K}) e^{-i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}, \qquad (1)$$

に比例する。式(1)の二番目の等号では,電子密度分布が自由な原子の和で書けるものと仮定した。X線の吸収を考慮に入れると,原子散乱因子 $f(\mathbf{K})$ および電子密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ は実効的に虚数関数になる。この実効的電子密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ は,複素屈折率 $n(\mathbf{r})$ と次の関係にある 15 ,

$$\rho(\mathbf{r}) = -\frac{k^2}{4\pi r_e} \left[n^2(\mathbf{r}) - 1 \right] \approx \frac{k^2}{2\pi r_e} \left[\delta(\mathbf{r}) - i\beta(\mathbf{r}) \right]. \tag{2}$$

ここで r_e は古典電子半径,kは真空中の波数を表す。式 (2)の最後の変形では,複素屈折率を $n=1-\delta+i\beta$ と,位 相のずれ(屈折)を表す実部の δ と,吸収を現す虚部の β に分離し,X 線に対してnの1からのずれが極めて小さいことを用いた。

吸収が無視でき電子密度分布が実数と見做せる場合,Friedel の法則の拡張 $F(-K) = F^*(K)$ が成立し,X 線回 折強度パターンは逆空間で中心対称 $|F(-K)|^2 = |F(K)|^2$ になる。この性質を利用すると,中心対称化により実効的なデータ精度が上がり,また,もしX 線回折強度が測定できない逆空間領域があっても,中心対称点でのデータがあれば補填可能である。

X線回折実験では、Fig. 3(a)に示すように、Ewald 球面上の回折強度が観測される。一方、X線回折顕微法の二次元投影像再生においては、逆空間原点を通る、投影面に平行な面内の回折強度データが必要とされる。このため、二次元投影像再生には、幾つかの入射角での回折強度パターンを組み合わせ、所望の平面内の回折強度データを得る必要がある。また、三次元像再生においてほぼ等方的な空間分解能を得るためには、逆空間原点付近のほぼ等方的な領域での X 線回折強度データが必要となる。これは、Fig. 3(b)に示すように、様々な入射角での X 線回折強度パターンを測定することにより実現する。

2.2.2 微小試料でかつ,空間分解能が波長に比べ低い場合の回折

微小試料の回折において、散乱角が小さく、再生像の空間分解能が波長に比べ低い場合を考える。この条件は散乱ベクトルの各成分が波数 k に比べ小さい, K_x , K_y $\ll k$,とする条件に等しく,Ewald 球を平面で近似することと等価である。このとき,式(1)は,

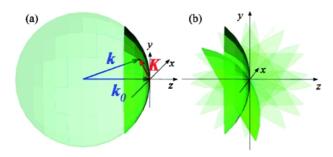


Fig. 3 Regions in reciprocal space covered by diffraction experiments. (a) Single diffraction measurement provides diffraction intensities in a near-forward region on the Ewald sphere. In measurement within a sufficiently small angle, the sphere may be approximated by a plane. (b) Diffraction data with a large number of different incident angles can cover nearly isotropic region around the reciprocal space origin.

$$F(K_x, K_y) = \int dx \int dy \left[\int dz \, \rho(\mathbf{r}) \right] e^{-i(K_x x + K_y y)}, \quad (3)$$

と変形できる。式(3)は、構造因子が試料の入射 X 線方向への投影像の Fourier 変換で与えられることを表している。すなわち、一つの入射角での X 線回折強度データから、試料の二次元投影像が再生できる。これは、実験データの解釈に多くの入射角での X 線回折強度測定が必要であった式(1)の状況と比べると、非常に重要な簡略化である。一方、高散乱角まで含む X 線回折強度データに式(3)を適用すると、二次元再生像には回折ぼけが生じる。

式(3)が成立し、かつ吸収が無視できる場合、二次元検出器上で観測される X 線回折強度パターンは中心対称性を持つ。これまで我々が SPring-8 BL29XUL で行ってきた実験では、これら近似が成り立つ場合のみを扱ってきた。今後、より高空間分解能を目指す際や、吸収の無視できない試料を扱う場合は、これまで用いてきた、装置、データ取得法およびデータ解析法を適宜変更する必要がある。

2.2.3 比較的厚い試料でかつ,空間分解能が波長に比べ 著しく低い場合の回折

試料が比較的に厚く多重弾性散乱が無視できない場合を考える。試料中での回折波の広がりが無視できる場合,試料背面での X 線波複素振幅は複素透過率に比例する。また,試料から十分遠方での X 線回折波の複素振幅は,試料背面での複素振幅の Fourier 変換に比例する。したがって, X 線回折波複素振幅は, 複素透過率の Fourier 変換に比例する。

複素透過率 q(x, y) は,多重散乱の効果を Rytov 近似で取り入れ,その短波長極限 $k \rightarrow \infty$ を取ると 16 ,

$$q(x, y) = \exp \left[-i\frac{2\pi r_{\rm e}}{k}\right] dz \,\rho(\mathbf{r})$$

$$pprox \exp \left[-ik \int dz \left[\delta(\mathbf{r}) - i\beta(\mathbf{r}) \right] \right],$$
 (4)

で与えられる。式(4)の最後の式変形では,電子密度分布と複素屈折率との関係式(2)を用いた。式(4)は試料の複素透過率が,位相のずれ δ および吸収 β に関する投影で与えられることを示している。これは,近似に用いた短波長極限において,試料内での回折波の広がりを無視しているためである。ちなみに,屈折の効果は,位相のずれ δ を通じて考慮されている。この複素透過率に対する投影近似は,位相コントラスト・イメージング法で多用されている。

式(4)の複素透過率に対する投影近似が成立する条件は、試料前面に存在する構造体による回折波の広がりが試料背面において所望の空間分解能 s よりも小さいとする、 $2t\lambda/s < s$ で与えられる。ここで t は試料の最大の厚さである。したがって、複素透過率の投影近似は、再生像の空間分解能が波長に比べ著しく低い場合、 $s > \sqrt{2t\lambda}$ 、に成立する。 X 線回折顕微法では、高空間分解能を目指すのが常であるので、この近似は適切とは言えない。また、位相コントラスト・イメージング法においても、式(4)に基づく解析法では、回折ぼけのため高空間分解能は得られない。

なお、式(4)に対し位相の空間変動が小さいとするいわゆる弱位相近似を適用すると $^{17)}$ 、X線回折波複素振幅は式(3)の構造因子の投影近似と等しくなる。しかし、2.2.2節の場合とは式の導出において異なる近似を用いているため、適用範囲が異なることに注意を要する。

3. オーバーサンプリング

3.1 オーバーサンプリング条件

X線回折顕微法では、回折強度パターンを細かくサンプリングすることにより構造因子(X線回折波複素振幅)の位相を回復する。位相回復に必要なサンプリング間隔の条件は、以下で論じるオーバーサンプリング条件で与えられる。

まず、試料が二次元の位相物体の場合(式(3)で $\rho(r)$ が実数の場合)を考える。Fig. 4(a)の SPring-8 のロゴマークを二次元試料像に見立て議論を進める。試料のサイズは $a_x \times a_y$ とし、これを $N_x \times N_y$ ピクセルに離散化する。離散化した二ピクセル分の大きさ $2a_{x,y}/N_{x,y}$ (または定義によっては一ピクセル分の大きさ $a_{x,y}/N_{x,y}$)が空間分解能に相当する。ここで $2a_{x,y}/N_{x,y}$ は、x 方向に $2a_x/N_x$ 、y 方向に $2a_y/N_y$ の大きさを持つ事を意味する。以下の数式の表記においても、同様の略記を用いる。離散化した試料像が担う情報量は N_xN_y [実数]である。ここで、[実数] は実数が担う情報量を表す。

構造因子の計算値は、式(3)より、試料像を Fourier 変換することにより得られる。ここで、離散化した逆空間の

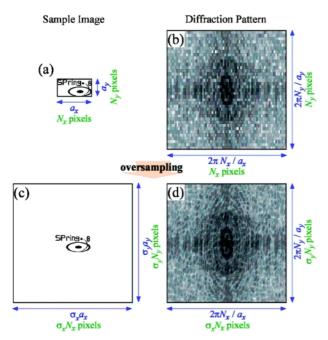


Fig. 4 Diffraction patterns with different sampling intervals, and the corresponding real-space images. (a) Original sample image. (b) Calculated diffraction intensity pattern. With a finer sampling of the diffraction pattern as in (d), a no-electron-density region appears in the corresponding real-space image around the sample as shown in (c).

ーピクセルの大きさは、試料サイズに逆比例し、 $2\pi/a_{x,y}$ で与えられる。離散化した構造因子は $N_x \times N_y$ ピクセルの複素数であるが、Friedel の法則の拡張により中心対称な点は複素共役な値を持つため、独立な情報量は全体の半分である。したがって、構造因子は試料像と同じ N_xN_y [複素数]/ $2=N_xN_y$ [実数] の情報量を担う。これは、試料像と構造因子が Fourier 変換という一対一の可逆変換で結ばれていることによる当然の結果である。

実験では構造因子の絶対値の二乗に比例する X 線回折強度のみが測定される。 Fig. 4 (b) には回折強度パターンの計算値を示す。離散化した回折強度パターンは全情報量の半分である N_xN_y [実数]/2 を担い,直接測定できない位相が残りの半分の情報を担う。このように,試料サイズが $a_{x,y}$ のとき,逆空間で $2\pi/a_{x,y}$ の間隔で X 線回折強度パターンをサンプリングすると,位相情報は完全に失われ,情報量の不足のため回復することはできない。

次に、X線回折強度パターンをより細かくサンプリングした場合を考える。Fig. 4(d)に横方向に σ_x 倍,縦方向に σ_y 倍細かくサンプリングした回折強度パターンを示す。ここで $\sigma_{x,y}$ は各方向のオーバーサンプリング比と呼ばれる $^{18)}$ 。この場合,逆空間の一ピクセルの大きさは $^{2\pi/2}$ ($\sigma_{x,y}a_{x,y}$)である。また,離散化した回折強度パターンは $\sigma_xN_x\times\sigma_yN_y$ ピクセルで,情報量は $\sigma_x\sigma_yN_xN_y$ [実数]/2となる。逆空間ではこの場合も,測定可能な情報(X線回折強度パターン)が全情報量の半分しか担わない状況は変

わらない。

ところが,実空間では以下に示すように状況は異なる。 Fig. 4(c)に,Fig. 4(d)の回折強度パターンに対応する実空間像を示す。この場合も,回折強度パターンの最大散乱角は変わらないため,空間分解能は変わらない。したがって,試料領域は $N_x \times N_y$ ピクセルである。一方,実空間全体は逆空間同様 $\sigma_x N_x \times \sigma_y N_y$ ピクセルとなる。このため,試料像の周りに電子密度ゼロの領域が現れる。

X線回折顕微法では、電子密度がゼロでない領域、すなわち試料の概形を大まかにであっても予め知っていることが望ましい。試料の概形に関する事前の情報がない場合には、電子密度分布の自己相関関数(X線回折強度パターンのFourier変換)や、以下に示すように、スペックルのサイズから見積もることも原理的には可能である。数学用語で、ある関数値がゼロでないパラメータ領域をサポートと呼ぶが、X線回折顕微法でも電子密度がゼロでない領域をサポートと呼ぶ。

実空間でサポートの情報が与えられると、サポートの外では電子密度がゼロという拘束条件を付加できる。サポートが担う情報量は最大で($\sigma_x\sigma_y$ -1) N_xN_y [実数]である。サポートの情報量が逆空間で失われた位相の情報量 $\sigma_x\sigma_y$ N_xN_y [実数]/2以上になれば、位相回復の必要条件が満たされる。すなわち、電子密度ゼロ領域がサポートよりも大きいことが要求される。この条件は $\sigma_x\sigma_y \ge 2$ で与えられ、二次元像再生のオーバーサンプリング条件と呼ばれる18)。また、 $\sigma_x\sigma_y$ は二次元像再生のオーバーサンプリング比と呼ばれる。

2.1節で見たように,X線回折顕微法で扱う微小試料の回折強度パターン中にはスペックルと呼ばれる斑点模様が現れ,スペックルのサイズは $2\pi/a_{x,y}$ である。オーバーサンプリング比 $\sigma_{x,y}$ の場合,逆空間でのサンプリング間隔が $2\pi/(\sigma_{x,y}a_{x,y})$ なので,スペックル中には $\sigma_{x}\sigma_{y}$ ピクセルが含まれる。したがって,二次元像再生のオーバーサンプリング条件は,スペックル中に 2 ピクセル以上含むと言い換えることができる。また,実験において試料サイズ(サポート)を予め知らない場合でも,スペックルの検出器上でのピクセルサイズからはオーバーサンプリング比 $\sigma_{x,y}$ が求まるので,これと逆空間でのサンプリング間隔 $\Delta K_{x,y}$ から,試料サイズを $2\pi/(\sigma_{x,y}\Delta K_{x,y})$ と見積もることが可能である。

上の例では二次元実数像の再生を取り扱ったが、二次元複素数像の場合も同様な議論ができる。違いは、実空間では複素数像を扱うので情報量が二倍になり、逆空間でもFriedel の法則の破れから情報量が二倍になるという点だけである。結局、オーバーサンプリング条件は二次元実数像の場合と同じ $\sigma_x\sigma_y\geq 2$ で与えられる。

二次元以外の実数および複素数の像再生においても、位相は測定されず、逆空間で必要な情報の半分が失われている状況は変わらない。このため、オーバーサンプリング条

件は、一次元の場合 $\sigma_x \geq 2$ 、三次元の場合 $\sigma_x \sigma_y \sigma_z \geq 2$ で与えられる¹⁸⁾。いずれの場合も、N次元像再生のオーバーサンプリング条件は、スペックルが占める N次元領域中のサンプリング点が 2以上と言い換えることができる。

X線回折顕微法実験においてオーバーサンプリング条件を単純に満たすためには、電子密度ゼロ領域が必要となる。したがって、試料は三次元的に有限の大きさを持つ微粒子か、二次元的に有限の大きさを持つワイヤー(ロッド)形状¹⁹⁾を持つことが求められる。

3.2 サンプリング定理

オーバーサンプリング条件と類似の事柄に、サンプリング定理に基づくオーバーサンプリングがある。サンプリング定理とは、連続的に変化するアナログ信号を、一定間隔の離散点でサンプリングしデジタル化する場合、どの程度細かくサンプリング点間隔を取れば元のアナログ信号を完全に復元できるかを与える数学的な定理である。この定理によると、アナログ信号に含まれる最小の周期の二分の一よりも細かくサンプリング点間隔を取ることが要求される「1)。この最小周期の二分の一の間隔(Nyquist 間隔)でのサンプリングは Nyquist サンプリングまたは臨界サンプリングと呼ばれ、これよりも細かいサンプリングはオーバーサンプリング、荒い場合はアンダーサンプリングと呼ばれる。アンダーサンプリングの場合、エリアシングが起こり、元のアナログ信号を完全に復元することはできない。

サンプリング定理を X 線回折に適用する。サイズ $a_{x,y,z}$ の試料の構造因子に含まれる最小の周期は,式(1) より 4π $/a_{x,y,z}$ である。また回折強度パターンは,この二分の一の周期 $2\pi/a_{x,y,z}$ の振動成分を含む。したがって,X 線回折強度パターンに対する Nyquist 間隔は, $\pi/a_{x,y,z}$ で与えられる 4,20 。この場合,3.1節で定義したオーバーサンプリング比 $\sigma_{x,y,z}$ は 2 である。以上より,サンプリング定理に基づく用語では, $\sigma_{x,y,z}=2$ が Nyquist サンプリング, $\sigma_{x,y,z}>2$ がオーバーサンプリングとなる。

一次元像に対してはサンプリング定理に基づくオーバーサンプリングと位相回復のためのオーバーサンプリング条件は等号を除き一致する。一方、二次元像や三次元像では、サンプリング定理に基づくオーバーサンプリングはオーバーサンプリング条件よりも厳しい制限となる。このように、サンプリング定理に基づくオーバーサンプリングを、3.1節で論じたオーバーサンプリング条件とは、厳密な意味では異なるが、X線回折顕微法では、両者の区別をあいまいにした形でオーバーサンプリングという用語が使われることが多い。

サンプリング定理は X 線回折強度の情報を完全に復元できても、位相は一般に回復できないという点に注意を要する。サンプリング定理に基づく位相回復が例外的に可能なケースとして、試料が中心対称性を持つ場合が挙げられ

64)。この場合,構造因子は実数になり,位相は0または π (正または負の実数)のいずれかとなる。この位相(符号)は,サンプリング定理から復元された回折強度パターンのゼロ点から推定可能である。

3.2.1 X線結晶構造解析法におけるサンプリング定理

本論から少し離れるが、X線結晶構造解析法とサンプリング定理との関わりについて触れる。結晶構造因子F(K)の定義式(式(1)の右辺の積分範囲を単位胞とした表式)では実空間座標rに関して連続積分が行われる。この逆 Fourier 変換は,逆格子ベクトルKに関しての連続積分である。したがって,もし単純に逆 Fourier 変換により結晶構造(単位胞中の電子密度分布)を決定しようとすると,連続的なKでの結晶構造因子が必要となる。しかし,X線結晶構造解析法の Fourier 合成,

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{1}{v_c} \sum_{\mathbf{g}} F(\mathbf{g}) e^{i\mathbf{g} \cdot \mathbf{r}}, \tag{5}$$

では,実験データが存在する逆格子点gでの結晶構造因子のみが用いられる。これは以下のようにサンプリング定理を考慮すると正当化される 4)。なお,多く見受けられる証明では,無限の大きさの完全結晶の空間的周期構造を仮定するが,サンプリング定理に基づく証明ではこの仮定を必要としない。

結晶構造が単位胞と格子の畳み込み積分で与えられることから理解できるように、"結晶"に対する回折強度測定は、"単位胞"の回折強度パターンを逆格子点でサンプリングしていることに等しい。結晶構造因子の定義式から、結晶構造因子に含まれる最短の周期は、基本格子ベクトルの長さを $|a_i|$ とすると、対応する逆格子ベクトルの方向 b_i に $4\pi/|a_i|$ である。このため結晶構造因子に対する Nyquist 間隔はこの二分の一の $2\pi/|a_i|$ で、逆格子点の間隔 (Bragg 間隔) と等しい。したがって、サンプリング定理より、逆格子点での結晶構造因子は結晶構造を再生するのに十分な情報を含んでおり、連続的な K での結晶構造因子は必要ではないことが証明される。

同様の考察から、単位胞の X 線回折強度パターンに対する Nyquist 間隔は Bragg 間隔の半分であり、半整数の Miller 指数での回折強度データが必要である⁴⁾。したがって、この Fourier 変換である、"単位胞"の電子密度分布の自己相関関数を得るには、半整数の Miller 指数での回折強度データが必要である。一方、"結晶"の電子密度分布の自己相関関数である Patterson 関数は、結晶と同じ空間的周期構造を持ち、実験データが存在する逆格子点(整数の Miller 指数)での X 線回折強度のみから計算できる。

4. 反復的位相回復

X線回折顕微法において,オーバーサンプリング条件が位相回復の必要条件であることを3.1節で示した。一方,オーバーサンプリング条件は位相回復の十分条件ではない。すなわち,オーバーサンプリング条件を満たしても,位相回復ができるかどうかは,現在の数学的知識では不明である。実用的には,Ralph Gerchberg と Owen Saxton により提唱された反復法60で位相回復を行うことが可能であり,X線回折顕微法ではこれに基礎を置く手法が用いられている。以下では,この反復的位相回復法について解説する。

4.1 Gerchberg-Saxton の反復法

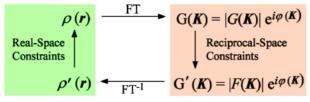
X線回折顕微法における X線回折強度データからの位相回復には、Gerchberg と Saxton に端を発する反復法が用いられる 6)。なお、参考文献 6)の Gerchberg と Saxtonのオリジナル論文では、実空間および逆空間での強度が既知の場合が扱われたが、実空間の強度を用いず、逆空間の強度のみから位相回復を行う拡張は、James Fienup によってなされた 21)。

Fig. 5 に反復法の概念図を示す。反復法では、ランダムな電子密度分布(またはランダムな位相)から出発し、Fourier 変換と逆 Fourier 変換を繰り返す。そして各反復において実空間および逆空間で既知の情報を補う。

まず、逆空間ではX線回折強度の実験データを補う。この際、位相は各反復における計算値を採用する。第n反復における構造因子の計算値を $G_n(K)$ とすると、逆空間拘束を課した後の構造因子 $G'_n(K)$ は、

$$G'_n(\mathbf{K}) = \frac{|F(\mathbf{K})|}{|G_n(\mathbf{K})|} G_n(\mathbf{K}), \tag{6}$$

で与えられる。ここで $|F(\mathbf{K})|$ は,X線回折強度の実験データから求めた構造因子の絶対値を示す。さらに, $G'_n(\mathbf{K})$ を逆 Fourier 変換することにより,逆空間拘束条件を満たす電子密度分布 $\rho'_n(\mathbf{r})$ が得られる。



Exp. Diffraction Intensity $\propto |F(\mathbf{K})|^2$

Fig. 5 Conceptual scheme of iterative phase retrieval. The phase set is recovered by iteratively applying Fourier transform and inverse Fourier transform with constraints in both reciprocal and real space at each iteration.

実空間では、電子密度がサポートの外ではゼロであること、また物理的に電子密度が負でない値を持つことが拘束 条件として課される。最も単純には、実空間拘束条件は、

$$\rho_{n+1}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \rho'_n(\mathbf{r}), & (\mathbf{r} \in S) \land (\rho'_n(\mathbf{r}) \ge 0), \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$
 (7)

で与えられる。ここで,Sはサポートを表す。実空間拘束条件を課した電子密度分布 $\rho_{n+1}(\mathbf{r})$ を Fourier 変換することにより,第 (n+1) 反復目の構造因子の計算値 $G_{n+1}(\mathbf{K})$ が得られる。その後,式(6) からの手順が繰り返され,反復が進んでいく。

式(7)を用いた方法では、位相回復の誤差が常に減少する(または変化しない)ので、誤差低減アルゴリズムと呼ばれる。また、このアルゴリズムは最急降下法と見做すこともできる 7 。この Gerchberg と Saxton の手法は、X 線結晶構造解析において位相改良法として用いられる溶媒平滑化法と酷似していることが多くの研究者によって指摘されている。

4.2 Fienup の HIO アルゴリズム

Gerchberg-Saxton の反復法の単純な拡張である誤差低減アルゴリズムは、最急降下法に基づくため、誤差空間の局所最小値に陥り易く、大域最小値を見つけることが困難である。この困難を解決する強力な手法が、Fienup により提案された HIO (hybrid input-output) アルゴリズムである 7 。HIO アルゴリズムでは、式 7 の代わりに、 6 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4 5

$$\rho_{n+1}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \rho'_n(\mathbf{r}), & (\mathbf{r} \in S) \land (\rho'_n(\mathbf{r}) \ge 0), \\ \rho_n(\mathbf{r}) - \beta \rho'_n(\mathbf{r}), & \text{otherwise,} \end{cases}$$
(8)

で与えられる。式(8)では,実空間拘束条件を満たさない場合に,電子密度をゼロとはせず,徐々に減らしていく。式(8)の β は電子密度を徐々に減らす度合いを制御するパラメータで,経験的に1付近の値が収束性が良いとされている。

HIO アルゴリズムにおいて、電子密度分布の推定として意味を持つのは、逆空間拘束条件を満たす $\rho_n'(r)$ である。ここで注意すべき点は、電子密度分布の推定 $\rho_n'(r)$ は、位相回復の誤差の度合いにかかわらず、常に X 線回折強度の実験データを再現するということである。また、HIO アルゴリズムにおいては、 $\rho_n(r)$ や $G_n(K)$ は、式(7)の実空間拘束条件も、式(6)の逆空間拘束条件も満たさず、補助的に現れる関数としての意味合いしか持たない。

HIO アルゴリズムでは、収束誤差は反復の途中で一時的に増えることもあるが、大域最小値を探し出す収束性は非常に優れている。この優れた性質のため、X線回折顕

微法では、HIO アルゴリズムに基づく位相回復が一般的 に行われている。

4.3 差分写像

位相回復の異なった手法として、Veit Elser によって提唱された差分写像(differential map)法がある $^{22)}$ 。差分写像法は、いくつかの拘束条件を満たす電子密度分布を探し出すより一般的な手法で、X線回折顕微法やX線結晶構造解析に応用できる。この手法はHIO アルゴリズムを特別な場合として含み、かつHIO アルゴリズムの収束性がなぜ優れているかの根拠に関して一定の説明を与える。

差分写像法にはいくつかのパラメータが存在するが、それらパラメータの間にある関係が成立するとき、最適収束条件が満たされる。差分写像法をX線回折顕微法に適用すると、HIO アルゴリズムで $\beta=1$ がこの最適収束に当てはまる。これにより、従来経験的に行われてきた β が1付近とする選択を正当化する説明が与えられた。また、HIO アルゴリズムとは別の最適収束するパラメータセットでの差分写像でも、HIO アルゴリズムと同等の収束性のよい位相回復が行えることも示された。差分写像法はHIO アルゴリズムを拡張した優れた数学的前進であるが、これまでのところHIO アルゴリズムを凌ぐ位相回復法を提示している訳ではない。

4.4 反復の収束と解の一意性

位相回復の誤差は、X線回折顕微法では、通常実空間で定義され、例えば、

$$E_n = \left[\sum_{\boldsymbol{r} \in S} |\rho'_n(\boldsymbol{r})|^2 / \sum_{\boldsymbol{r}} |\rho'_n(\boldsymbol{r})|^2 \right]^{1/2}, \tag{9}$$

で与えられる。すなわち、サポートの外で電子密度が如何に小さいかが誤差の指標となる。ちなみに、X線結晶構造解析では逆空間で位相回復の誤差であるR因子が定義されるが、HIO アルゴリズムでは $G_n(\mathbf{K})$ は前述のように補助関数的な意味合いしか持たず、また $|G_n'(\mathbf{K})|$ は常に実験データと等しいため、逆空間で適切な誤差を定義できない。

理想的には、誤差 E_n がゼロになったとき(且つ、サポート内で電子密度分布 $\rho'_n(\mathbf{r})$ が非負のとき)、 $\rho'_n(\mathbf{r})$ は実空間拘束条件も逆空間条件も満たす解となる。これら条件を満たす解が見つかったとき、それが真の解と言えるか、言い換えれば、実空間拘束条件も逆空間拘束条件も満たす偽の解が存在するかについては、古くから多くの議論がある 23,24 。

まず、X線回折顕微法における解の自明な非一意性について述べる。もし $\rho_n'(r)$ が実空間拘束条件も逆空間拘束条件も満たす解のとき,電子密度分布を実空間拘束条件を満たす範囲で r_0 だけ併進移動させた $\rho_n'(r+r_0)$ も自動的に

解となる。これは、 $\rho_n'(\mathbf{r})$ と $\rho_n'(\mathbf{r}+\mathbf{r}_0)$ の構造因子は全体に掛かる位相因子 $\exp(-\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}_0)$ だけ異なり、同じ \mathbf{X} 線回折強度パターンを与えるためである。また、空間反転した電子密度 $\rho_n'(-(\mathbf{r}+\mathbf{r}_0))$ も、構造因子が元の複素共役で与えられ、 \mathbf{X} 線回折強度パターンは同一である。このため、サポートの条件が満たされれば解となる。これら自明な非一意な解のうち、反復的位相回復でどの解に収束するかは、最初に与えるランダムな電子密度分布(またはランダムな位相)に依存する。

この自明な非一意な解以外に偽の解が存在するかについては、以下の結論で大方のコンセンサスが得られている。(1)一次元像回復に対しては、偽の解が存在する²³⁾。(2)二次元以上の像回復については、偽の解が存在することは病的にまれ(pathologically rare)である²⁴⁾。二次元以上の像回復においても、対称性から一次元に帰着できる場合(例えば、同心円状構造)には、偽の解が存在する。

以上は理想的な場合を扱ったが、実際の計算では精度が限られているので、どこまで誤差 E_n が小さくなれば解とするかの判断にあいまいさが残る。更に、実際の実験データにはノイズやデータが測定できない領域が含まれる。これらデータの不完全性のため、二次元以上の像回復においても偽の解の存在は否定できない。特に、X 線回折の実験データでは、前方付近のビームストップの影の領域に常にデータの欠如領域が存在するが、この場合、実空間拘束条件も逆空間条件も近似的に満たす偽の解が存在することが指摘されている 25,26 。これらの問題に関しては、今後更なる数学的な理解の進展が不可欠である。

4.5 前方付近のデータ欠如の問題

X線回折顕微法の実験データからの像再生では,最近に至るまで,X線回折強度データに加え,別実験(例えば,軟X線顕微鏡)による低空間分解能の試料像を必要としていた。これは実用上の大きな障害で,X線回折顕微法の主な問題点とされてきた。この問題を克服する位相回復法の改良が,我々のグループによって提案されたのでここで紹介する 27 。

この問題の原因は、X線回折強度実験データに常に存在する、ビームストップの影となる前方付近のデータ欠如である。欠如データは、全電子数や試料概形といった重要な情報を担っているため、X線回折強度データのみからの試料像再生が格段に難しくなる。ちなみに、式(1)から分かるように、K=0の前方散乱 X線回折強度が全電子数を決める。

我々は,前方付近に大きなデータ欠如がある場合,通常の HIO アルゴリズムでは全電子数の計算値が反復と共に無秩序に増加することを見出した。そしてこの問題を解決するため,HIO アルゴリズムに全電子数を反復的に規格化する改良を加えた,MHIO (modified HIO) アルゴリズムを開発した 27)。

MHIO アルゴリズムでは、式(6)が変更される。具体的には、X線回折強度実験データが存在する場合は、通常のHIO アルゴリズム同様に実験データを用い、実験データが存在しない場合は、計算値 $G_n(\mathbf{K})$ を用いる。ただし、 $\mathbf{K}=0$ の前方散乱に対してのみ、全電子数の規格化因子 $m_n^{(0)}$ を掛ける。これを数式で表すと、

$$G'_{n}(\mathbf{K}) = \begin{cases} \frac{|F(\mathbf{K})|}{|G_{n}(\mathbf{K})|} G_{n}(\mathbf{K}), & \mathbf{K} \in D, \\ G_{n}(\mathbf{K}), & (\mathbf{K} \notin D) \wedge (\mathbf{K} \neq 0), \\ m_{n}^{(0)} G_{n}(0), & \mathbf{K} = 0, \end{cases}$$
(10)

となる。ここで、規格化因子 $m_n^{(0)}$ は、

$$m_n^{(0)} = \alpha \left(\frac{\sum_{K \in D} 1}{\sum_{K \in D} |F(K)| / |G_n(K)|} - 1 \right) + 1,$$
 (11)

で与えられる。ここで,Dは実験データが存在する逆空間領域を示し, α はパラメータで0.5から1の間の値が経験的に収束性が良い。式(11)に示すように,規格化因子 $m_n^{(0)}$ は,X線回折強度実験データから決定し,実験的に決定できない真の全電子数は用いない。

この MHIO アルゴリズムを用いることで、全電子数が真の値に収束することがシミュレーションで示された。また、このアルゴリズムを SPring-8 BL29XUL で測定した金のナノ構造パターン試料の実験データに適用することにより、硬 X 線領域で世界初の X 線回折強度実験データのみからの試料像再生に成功した。

X線回折強度実験データのみからの試料像再生を可能にする他の方法として、Shrink-Wrap 法と呼ばれる反復的にサポートを変更する手法も提案されている $^{28)}$ 。

5. X 線のコヒーレンス

X線回折顕微法では、入射 X線のコヒーレント領域は 試料サイズより大きくなければならない。すなわち、試料 中のどんなに離れた二点で散乱された X線同士も十分に 干渉しなければならない。シンクロトロン放射光のような カオス光に対して、この条件は $^{29-31}$ 、

横コヒーレンス長_{x,y}=
$$\frac{\lambda R}{2\pi\sum_{x,y}}$$
> $a_{x,y}$, (12)

で与えられる。ここで, $a_{x,y}$ は試料 RMS サイズ, λ は波長, $\Sigma_{x,y}$ は光源 RMS サイズ,R は光源から試料までの距離を表す。光源のパワーを有効活用するよう,コヒーレント領域を試料サイズよりやや大きめに整合させることも重要である。

低エミッタンス電子ビーム蓄積リングのアンジュレータ 放射光では、垂直方向では回折限界エミッタンスを実現しており、コヒーレンスに優れている。我々が SPring-8 でこれまで行ってきた X 線回折顕微法実験の典型的な場合では、垂直方向の X 線ビームサイズは試料サイズ(1μ m 程度)の100倍のオーダーで、多くのコヒーレントフラックスを無駄にしている。今後、試料位置に X 線を集光させることも検討に値する。この場合、集光素子後の X 線の波面の精密決定が問題となる。一方、水平方向では電子ビームのエミッタンスが悪く、放射パワーの大部分を占めるインコヒーレントなフラックスが無駄になっている。水平方向のコヒーレンス長は垂直方向に比べ著しく短いが、SPring-8 でのこれまでの典型的実験では、試料サイズと同程度を確保している。

これに対し、計画が進められている SASE FEL では、垂直水平の両方向で回折限界を達成した完全な空間コヒーレンスを持つ X 線が得られる。また、横方向平面内で等方的なビームサイズを持つことは、多くの X 線回折顕微法実験にとって都合が良い。アンジュレータ放射の角度発散は、アンジュレータ長を L とすると $\sqrt{\lambda/L}$ で与えられるので 32 、非常に長い($\sim 100~\mathrm{m}$)アンジュレータを持つSASE FEL は、指向性に優れている。さらに、コヒーレント領域を試料サイズに整合させれば、放射パワーを最大限利用した理想的な実験が実現する。

縦(時間)方向のコヒーレンスに関しては、コヒーレンス長が最大の光路差よりも長い必要がある。この条件は29-31),

縦コヒーレンス長=
$$\frac{\sqrt{2 \ln 2}}{\pi} \frac{\lambda^2}{4 \lambda} > \frac{\lambda a_{x,y}}{s}$$
, (13)

で与えられる。ここで、 $\Delta\lambda$ は波長 FWHM バンド幅、s は所望の空間分解能を表す。式(13)から分かるように、要求される縦コヒーレンス長は、所望の空間分解能が短いほど長い。逆の言い方をすると、縦コヒーレンス長は再生像の空間分解能の最小値を制限する。したがって、大きなサイズの試料に対し高空間分解能を達成するには、バンド幅の狭い X 線が要求される。

アンジュレータ放射(k次高調波)の縦コヒーレンス長は、アンジュレータ周期数をNとすると、おおよそ $kN\lambda$ で与えられる 33 。非常に大きい周期数($N\sim10^4$)のアンジュレータを持つ SASE FEL は、バンド幅が狭いため、分光器を用いず X線回折顕微法実験を行うことも検討に値する。

式(13)の条件が満たされていれば時間モード数が多く ても、可視度を損なうことなく回折を起こす。すなわち、 X線回折顕微法実験において、凝縮パラメータ(ボーズ 縮重度)^{29,30)}の高さは直接的には要求されない。したがっ て、SASE FEL は、蓄積リングのアンジュレータ放射光 同様、時間方向は多モードであるが、X線回折顕微法実験に悪影響を与えない。

X線回折顕微法実験において,試料の静的構造の測定では平均輝度の高さが求められ,ダイナミクスに関わる測定ではピーク輝度の高さが求められる。SASE FEL は従来の蓄積リングのアンジュレータ放射光に比べ,平均輝度でおよそ4桁,ピーク輝度に至っては8桁以上も高い 34 。このため,SASE FEL では,単一パルスの照射で得たX線回折強度データを多数組み合わせ,単分子試料の三次元構造を得ることも可能になると期待されている 35 。

6. 世界的な研究の状況

この節では、1999年のX線回折顕微法の最初の実験的成功以降の、実験面での世界的な研究の状況を概説する。

我々のグループは、X線回折顕微法の最初の実験を行った Miao らと共同で、SPring-8 理研物理科学ビームライン BL29XUL において、より波長の短い硬 X線を用いた高空間分解能の X線回折顕微法実験を2001年に始め、基礎・応用面での研究を推し進めた $^{14,36,37)}$ 。これまでに、大腸菌から半導体材料に至る広範な試料の測定に成功している $^{26,38-40)}$ 。また、更なる空間分解能の向上を目指し、真空仕様の大面積イメージングプレート検出器の開発を行っている 36 。

X線回折顕微法の先駆的研究を続けてきた New York 市立大学 Storny Brook 校のグループは、最初の実験的成 功の後、ALSの軟X線ビームライン9.0.1に実験の場を移 し新たな装置開発を進めた41)。ALSに移った最大の理由 は、NSLSに比べコヒーレントフラックスが多く、X線回 折顕微法実験に適しているためである。この新たに開発さ れた装置を使い、現在までのところ、大きく分けて二つの グループが実験を行っている。一つは装置開発を手掛けた Stony Brook グループで、イースト菌を試料に用いた測定 をこれまでに行っている25)。もう一つのグループは, Lawrence Livermore 国立研究所, Arizona 州立大学, ALS の合同チームである。彼らは、ALS にあった前身の 装置で, 金のナノ粒子を試料に用いた実験を行っていた が^{28,42)}, その後, Storny Brook グループが開発した装置 に乗り換え実験を行っている。最近では、金のナノ粒子で 三次元的に作られたピラミッド状の試料の測定を行ってい る⁴³⁾。彼らは、将来の X 線 SASE FEL 実験をにらんで、 DESY の VUV FEL 施設 TTF (TESLA Test Facility) を 用いた単分子測定44)のスタディを計画している。

少し趣きを異にした実験が、Illinois 大学の Ian Robinson らのグループによって進められている 45,46 。本稿で紹介した手法では、前方(逆空間原点近傍)の X線回折強度データを用いるが、彼らはナノ結晶試料に対する非前方の逆格子点近傍の X線回折強度データを用いて試料像を

再生する。これまでに、APSのビームライン34-ID-Cを用い、金のナノ結晶試料の二次元および三次元での試料像再生に成功している。彼らの手法には測定の簡便さにおいて多くの利点があるが、得られた試料像が、試料の結晶性の不完全さのため、電子密度分布に直接対応していないという難点がある。再生像の適切な解釈には、今後の理論面での進展が必要である。

最近になり、いくつかのグループが X 線回折顕微法実験に新たに参入している。一つは HASYLAB のグループで、これまでに ESRF のビームライン ID1 を用いた硬 X 線領域での実験を行っている。また、APS のビームライン 2-ID-B では、Miao らのグループが APS の顕微法グループと共同で、軟 X 線領域での実験を始めた。

7. おわりに

本稿では X 線回折顕微法の諸原理について解説した。 X 線回折顕微法実験が満たすべき条件は、3.1節で述べた オーバーサンプリング条件と、5 節で述べた X 線のコヒーレンスに関する条件、式(12)と式(13)、で与えられる。これら条件を満たす実験で得られた X 線回折強度 データからの試料像再生には、反復的位相回復法、特に、HIO アルゴリズムまたはその改変が一般に用いられることを述べた。以下、本稿の締め括りとして、蓄積リングのアンジュレータ放射光および SASE FEL を用いた実験に対する今後の展望について述べる。

X線回折顕微法の優れた能力は、蓄積リングのアンジュレータ放射光を用いたこれまでの実験でも既に実証されている。今後もし本手法をメインテーマの一つとするビームラインができ、測定が半自動化されれば、放射線損傷が問題とならない試料に対しては、ルーチン的測定が可能になるであろう。ただ、三次元構造解析を行う場合は、現状ではデータ解析に多くの時間を要するので、より効率のよい位相回復法や高速な計算機システムの開発が今後の課題となる。

卓越したコヒーレンス性能を誇る SASE FEL は、X線回折顕微法の飛躍的発展を促すと期待される。特に、極めて高いピーク輝度を利用した単一パスル照射での X線回折強度測定により、フェムト秒時間分解能での試料のスナップショットが得られると期待される。さらに、ポンプ・プローブ等の手法を用い、原子レベルでの構造変化のフェムト秒スナップショットムービー測定の可能性も論じられている。従来技術では到底なし得ないこれら実験が実現した際の、科学へのインパクトは計り知れない。

一方、SASE FEL を用いた実験における課題として、 試料の放射線損傷が挙げられる^{47,48)}。特に生物試料に対し ては、他の顕微法同様に、試料損傷が懸念される。単分子 試料では、単パルス照射時に試料が Coulomb 爆発するこ とが予測される。放射線損傷は、主に、光電吸収による試 料へのエネルギー付与によって引き起こされる。SASE FEL のような超短パルス光では、非線形プロセスによる線吸収率の減少、すなわち飽和吸収が起こることが予測される 47 。この現象は、内殻励起状態の光子吸収断面積が基底状態に比べ著しく小さいために起こり、内殻励起状態の寿命 (47)。の間に複数の光子が入射すると顕著になる。この飽和吸収による試料損傷の軽減に関しては、シミュレーションによる多くの予測が存在するが、実際にどのような状況が起こるかは SASE FEL の完成を待たなければならない。試料損傷が顕著になる前に、試料像再生に必要な統計精度を持った X 線回折強度データの取得が可能かが焦点となる。

謝辞

SPring-8 BL29XUL における X 線回折顕微法実験は, California 大 学 Los Angeles 校 の Jianwei Miao 博 士 , Changyong Song 博士, 理化学研究所播磨研究所の, 高橋 幸生博士, 香村芳樹博士らとの共同研究である。

参考文献

- J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics, 2nd edition (McGraw-Hill, New York, 1996).
- 2) http://www-xfel.spring8.or.jp/
- 3) 北村英男,新竹 積,石川哲也:放射光 16,77 (2003).
- 4) D. Sayre: Acta Crystallogr. 5, 843 (1952).
- D. Sayre: Imaging Processes and Coherence in Physics, ed. by M. Schlenker et al. (Springer Verlag, Berlin, 1980) 229.
- 6) R. W. Gerchberg and W. O. Saxton: Optik (Stuttgart) 34, 275 (1971).
- 7) J. R. Fienup: Appl. Opt. 21, 2758 (1982).
- 8) D. Sayre: Direct Methods of Solving Crystal Structures, ed. by H. Schenk (Plenum Press, New York, 1991), 353.
- W. B. Yun, J. Kirz and D. Sayre: Acta Crystallogr. A43, 131 (1987).
- D. Sayre and H. N. Chapman: Acta Crystallogr. A51, 237 (1995).
- D. Sayre, H. N. Chapman and J. Miao: Acta Crystallogr. A54, 232 (1998).
- J. Miao, P. Charalambous, J. Kirz and D. Sayre: Nature (London) 400, 342 (1999).
- 13) 本手法と同様の名称で、異なる手法を指す場合もあるので注意を要する。例えば、X線回折を利用した多結晶中の結晶粒の方位等のマッピングを行うthree-dimensional x-ray diffraction microscopyという手法や、x-ray diffraction topographyの日本語訳としてX線回折顕微法が用いられる場合がある。
- 14) 西野吉則, 石川哲也: まてりあ, in press.
- 15) M. Lax: Rev. Mod. Phys. 23, 287 (1951).
- 16) T. J. Davis: Acta Crystallogr. A50, 686 (1994).
- 17) P. Guigay: Optik (Stuttgart) 49, 121 (1977).
- J. Miao, D. Sayre and H. N. Chapman: J. Opt. Soc. Am. A 15, 1662 (1998).
- J. M. Zuo, I. Vartanyants, M. Gao, R. Zhang and L. A. Nagahara: Science 300, 1419 (2003).
- 20) C. Song, Y. Nishino, Y. Kohmura, R. Bergstrom, Y. Takahashi, T. Ishikawa, L. Graham, M. J. Glimcher and J. Miao: in preparation.

- 21) J. R. Fienup: Opt. Lett. 3, 27 (1978).
- 22) V. Elser: J. Opt. Soc. Am. A **20**, 40 (2003).
- Yu. M. Bruck and L. G. Sodin: Opt. Commun. 30, 304 (1979).
- 24) R. Barakat and G. Newsam: J. Math. Phys. 25, 2190 (1984).
- D. Shapiro, P. Thibault, T. Beetz, V. Elser, M. Howells, C. Jacobsen, J. Kirz, E. Lima, H. Miao, A. M. Neiman and D. Sayre: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102, 15343 (2005).
- 26) J. Miao, Y. Nishino, Y. Kohmura, B. Johnson, C. Song, S. H. Risbud and T. Ishikawa: Phys. Rev. Lett. 95, 085503 (2005).
- Y. Nishino, J. Miao and T. Ishikawa: Phys. Rev. B 68, 220101(R) (2003).
- 28) S. Marchesini, H. He, H. N. Chapman, S. P. Hau-Riege, A. Noy, M. R. Howells, U. Weierstall and J. C. H. Spence: Phys. Rev. B. 68, 140101(R) (2003).
- J. W. Goodman: Statistical Optics (John Wiley & Sons, New York, 1985).
- L. Mandel and E. Wolf: Optical Coherence and Quantum Optics (Cambridge University Press, Cambridge, 1995).
- 31) コヒーレンス長の"幅"の定義には異なる流儀が存在する。 参考文献29)の定義は、ここに示した表式に $\sqrt{\pi}$ を乗ずる。 また、幅の計算では Gauss 分布を仮定した.
- 32) K-J. Kim: Nucl. Instrum. Methods 246, 71 (1986).
- D. A. Attwood, K. Halbach and K-J. Kim: Science 228, 1265 (1985).
- 34) TESLA Technical Design Report, ed. by G. Materlik and Th. Tschentscher (2001).
- J. Miao, K. O. Hodgson and D. Sayre: Proc. Nat. Acad. Sci. USA 98, 6641–6645 (2001).
- 36) Y. Nishino, J. Miao, Y. Kohmura, Y. Takahashi, C. Song, B. Johnson, M. Yamamoto, K. Koike, T. Ebisuzaki and T. Ishikawa: Proceedings of the 8th International Conference on X-ray Microscopy (The Institute of Pure and Applied Physics, Tokyo) in press.
- 37) 西野吉則: Isotope News **594**, 2 (2003).
- 38) J. Miao, T. Ishikawa, B. Johnson, E. H. Anderson, B. Lai and K. O. Hodgson: Phys. Rev. Lett. 89, 088303 (2002).
- 39) J. Miao, K. O. Hodgson, T. Ishikawa, C. A. Larabell, M. A. LeGros and Y. Nishino: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, 110 (2003).
- J. Miao, J. E. Amonette, Y. Nishino, T. Ishikawa and K. O. Hodgson: Phys. Rev. B 68, 012201 (2003).
- 41) T. Beetz, M. R. Howells, C. Jacobsen, C.-C. Kao, J. Kirz, E. Lima, T. O. Mentes, H. Miao, C. Sanchez-Hanke, D. Sayre and D. Shapiro: Nucl. Instrum. Methods A 545, 459 (2005).
- 42) H. He, S. Marchesini, M. Howells, U. Weierstall, H. Chapman, S. Hau-Riege, A. Noy and J. C. H. Spence: Phys. Rev. B. 67, 174117 (2003).
- 43) H. N. Chapman, A. Barty, S. Marchesini, A. Noy, C. Cui, M. R. Howells, R. Rosen, H. He, J. C. H. Spence, U. Weierstall, T. Beetz, C. Jacobsen and D. Shapiro: arXiv:physics/0509066 (2005).
- 44) J. C. H. Spence and R. B. Doak: Phys. Rev. Lett. **92**, 198102 (2004).
- 45) I. K. Robinson, I. A. Vartanyants, G. J. Williams, M. A. Pfeifer and J. A. Pitney: Phys. Rev. Lett. 87, 195505 (2001).
- 46) G. J. Williams, M. A. Pfeifer, I. A. Vartanyants and I. K. Robinson: Phys. Rev. Lett. 90, 175501 (2003).
- 47) R. Neutze, R. Wouts, D. van der Spoel, E. Weckert and J. Hajdu: Nature (London) 406, 752 (2000).
- 48) M. R. Howells, T. Beetz, H. N. Chapman, C. Cui, J. M. Holton, C. J. Jacobsen, J. Kirz, E. Lima, S. Marchesini, H. Miao, D. Sayre, D. A. Shapiro and J. C. H. Spence: arXiv:physics/0502059 (2005).

●著者紹介●



西野吉則

理化学研究所播磨研究所放射光科学総合 研究センター・先任研究員

E-mail: nishino@spring8.or.jp 専門:X線光学,X線顕微法

[略歴]

1996年大阪大学大学院理学研究科物理 学専攻博士課程修了,理学博士。1996 年-2001年財高輝度光科学研究センター。 1998年-2000年ハンブルク放射光研究所 客員研究員。2001年-理化学研究所播磨 研究所。2005年10月より現職。



石川哲也

理化学研究所播磨研究所放射光科学総合

研究センター・副センター長 E-mail: ishikawa@spring8.or.jp

専門:X線光学

[略歴]

1982年東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士課程修了,工学博士。高エネルギー物理学研究所放射光実験施設助手,東京大学工学部助教授,理化学研究所・マイクロ波物理研究室主任研究員を経て,X線干渉光学研究室主任研究員。加速器工学,X線光学等の研究に従事。2005年10月より現職。

Principles of x-ray diffraction microscopy

Yoshinori NISHINO

RIKEN Harima Institute, RIKEN SPring-8 Center,

Tetsuya ISHIKAWA

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 678-5148, Japan

RIKEN Harima Institute, RIKEN SPring-8 Center,

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 678-5148, Japan

Abstract X-ray diffraction microscopy is an innovative method to reconstruct the electron density distribution from its x-ray diffraction intensity data with no need of sample crystallization. In experiments, it is essential that the whole region of a sample particle is illuminated with coherent x-rays, so that the x-ray diffraction intensity pattern has sensitivity to the sample structure in the wavelength spatial resolution. In the method, x-ray diffraction intensity patterns are sampled finely enough to satisfy the oversampling condition for solving the phase problem. The reconstruction of the sample structure from the diffraction intensity pattern is performed using an iterative method. An ambitious plan with future SASE FEL sources is under discussion, to measure snapshot images of sample structure in femto second time resolution.